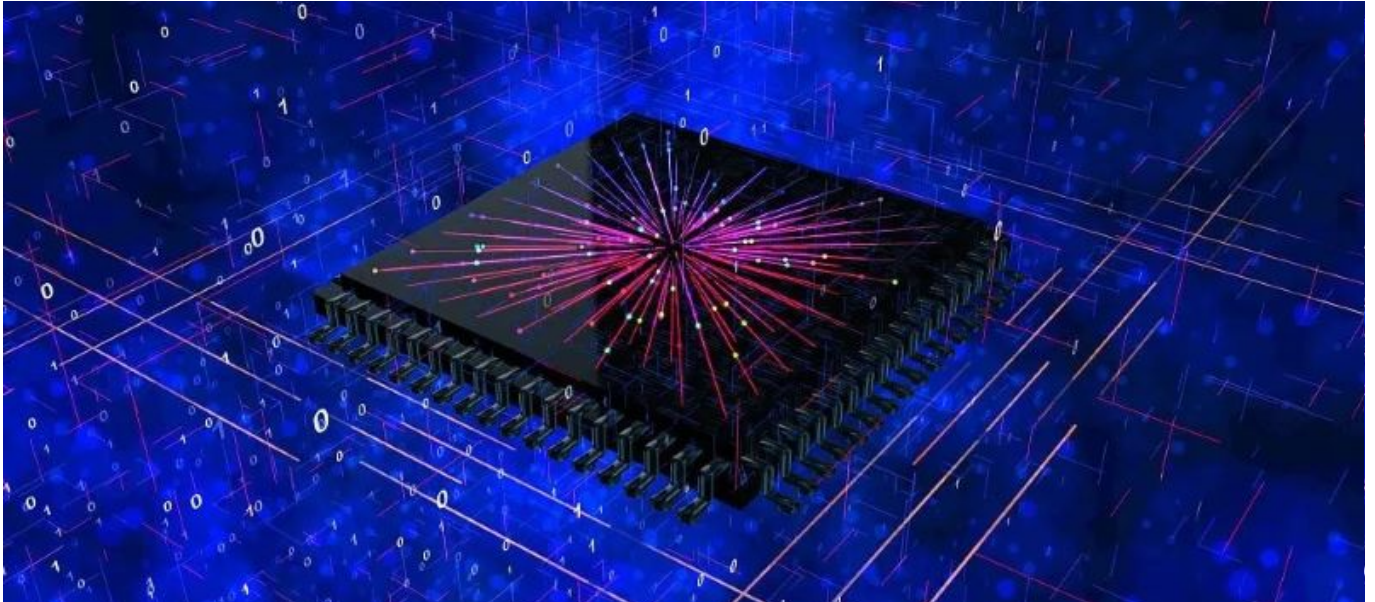




Científicos chinos crean memoria cuántica de un solo electrón que revolucionaría la computación

Posted on Julio 25, 2026

Los investigadores observaron el almacenamiento estable de un solo electrón a temperatura ambiente, cuando previamente se creía que era posible a temperaturas bajas

Un equipo de investigación de la **Universidad Fudan** en Shanghái ha desarrollado un innovador dispositivo de memoria flash cuántica bidimensional de un solo electrón que podría mejorar drásticamente la velocidad y la eficiencia energética de los futuros sistemas informáticos.

El estudio combina tres cualidades difíciles de lograr simultáneamente: alta velocidad, bajo consumo energético y capacidad de retener datos sin suministro eléctrico, de acuerdo con **China Daily**, socio de la red TV BRICS.

Esta tecnología podría satisfacer las crecientes demandas de procesamiento de la **inteligencia artificial general**, que requiere formas mucho más rápidas y eficientes de procesar y almacenar grandes volúmenes de datos.

Por primera vez, los investigadores observaron directamente el almacenamiento estable de un solo

electrón a temperatura ambiente (27 °C), cuando previamente se creía que este comportamiento cuántico solo era posible a temperaturas extremadamente bajas.

El dispositivo requiere un solo electrón para generar una ventana de memoria de 0,5 voltios, lo que contrasta con la tecnología DRAM avanzada actual que necesita unos 200.000 electrones para almacenar un bit.

Además, el equipo descubrió un nuevo efecto de memoria cuántica que proporciona una base teórica para futuras aplicaciones. Según los investigadores, esta memoria podría integrarse directamente con los procesadores, reduciendo los retrasos en la transferencia de datos y ampliando las aplicaciones de la IA en diversos sectores.

El Maipo/BricsTV